

**Elektrische Eigenschaften****Electrical properties****Höchstzulässige Werte****Maximum rated values**

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	600, 800	V
Vorwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$	1000, 1200	V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	1400, 1600	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	$t_C = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{TRMSM}$	800	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_C = 74^{\circ}\text{C}$	$I_{AVM}$	425	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$	$I_{TSM}$	510	A
Grenzlastintegral	$\int i^2 dt$ -value	$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$	$\int i^2 dt$	14500	A
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$		12500	A
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$		1051000	A <sup>2</sup> s
		$v_D \leq 67\% V_{DRM}, f_0 = 50\text{ Hz}$		781000	A <sup>2</sup> s
		$V_L = 10\text{ V}, i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	120	A/ $\mu\text{s}$
		$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 67\% V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	V/ $\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte****Characteristic values**

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 1500\text{ A}$	$V_T$	max.	1,5	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$	0,9	V	
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$r_T$	0,3	m $\Omega$	
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}$	$I_{GT}$	max.	250	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}$	$V_{GT}$	max.	1,5	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\text{ V}$	$I_{GD}$	max.	10	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,2	V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_A = 5\text{ }\Omega$	$I_H$	max.	300	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_{GK} \geq 10\text{ }\Omega$	$I_L$	max.	1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\text{ }\mu\text{s}$	$i_D, i_R$	max.	80	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	max.	4	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	$t_q$	typ.	250	$\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	$V_{ISOL}$		3	kV

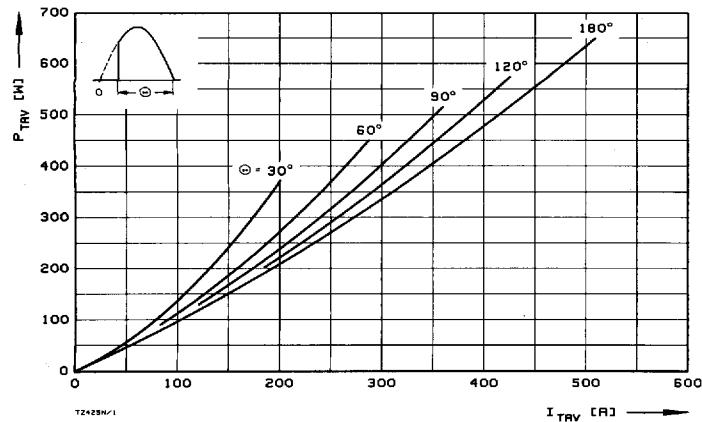
**Thermische Eigenschaften****Thermal properties**

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance,	$\Theta = 180^{\circ}\text{el, sinus: pro Modul/per module}$	$R_{thJC}$	max.	0,078°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	DC: pro Modul/per module	$R_{thCK}$	max.	0,02 °C/W
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur	max. junction temperature				
Betriebstemperatur	operating temperature				
Lagertemperatur	storage temperature				
			$t_{vj\ max}$		125°C
			$t_{cop}$		-40°C ... +125°C
			$t_{stg}$		-40°C ... +130°C

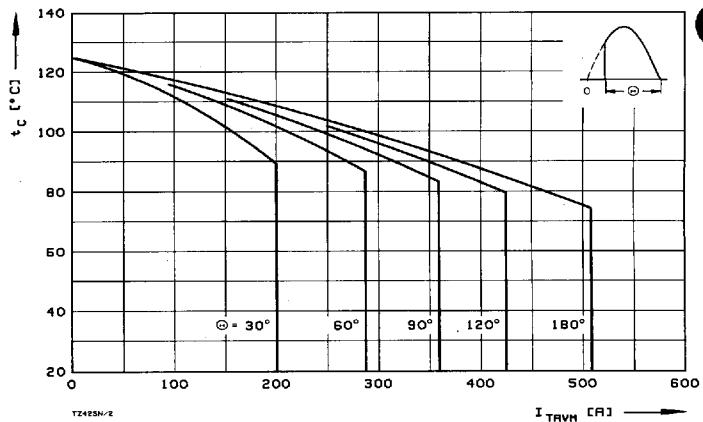
**Mechanische Eigenschaften****Mechanical properties**

Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellets with pressure contact				AlN
Innere Isolation	internal insulation				
Anzugsdrehmomente	tightening torques				
mechanische Befestigung	mounting torque				
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque				
Gewicht	weight	Toleranz/tolerance ± 15%		M1	6 Nm
Kriechstrecke	creepage distance	Toleranz/tolerance + 5%/-10%		M2	12 Nm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz		G	typ. 900 g
Maßbild	outline				15 mm
					5 · 9,81 m/s <sup>2</sup>
					9

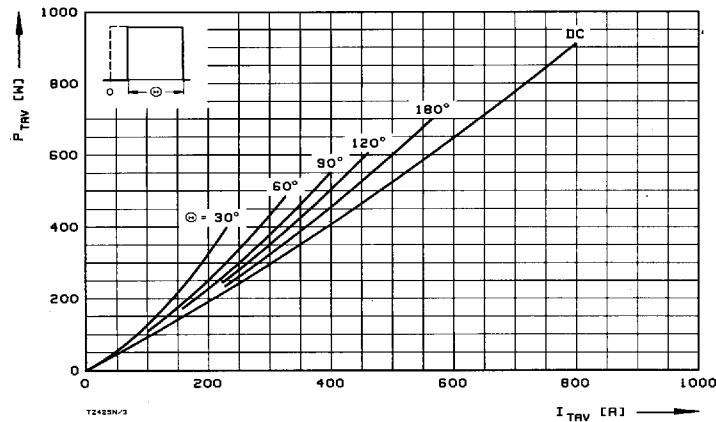
TZ 425 N



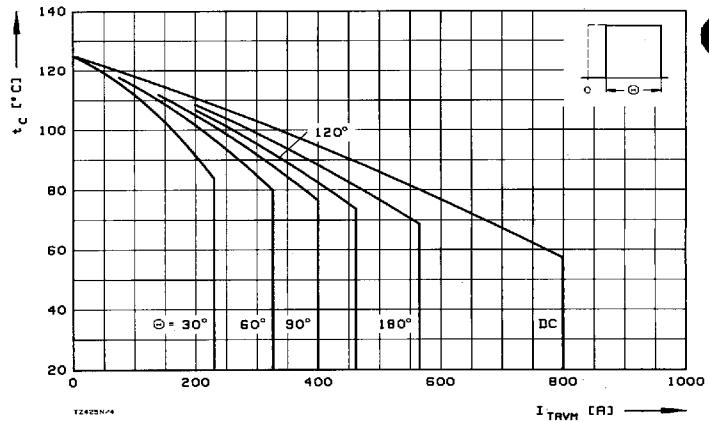
Bild/Fig. 1  
Durchlaßverlustleistung/On-state power loss  
Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle  $\Theta$



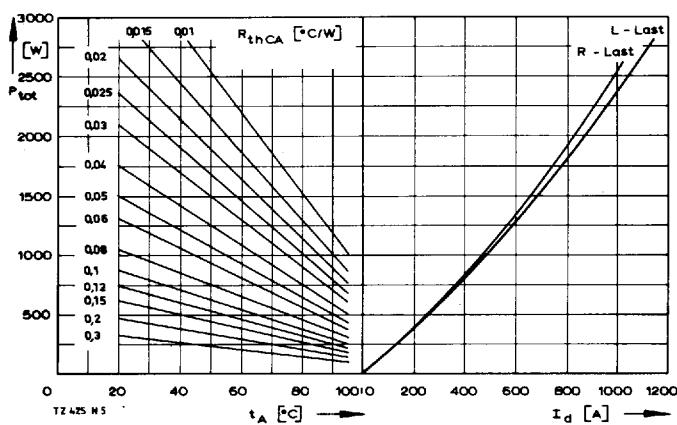
Bild/Fig. 2  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_c$   
Maximum allowable case temperature  $t_c$



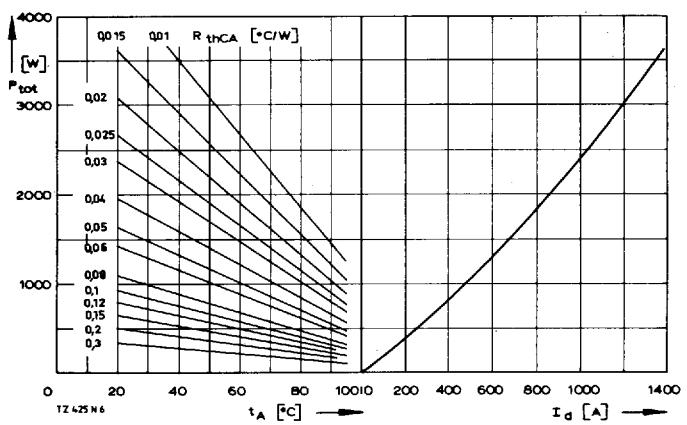
Bild/Fig. 3  
Durchlaßverlustleistung/On-state power loss  
Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle  $\Theta$



Bild/Fig. 4  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_c$   
Maximum allowable case temperature  $t_c$

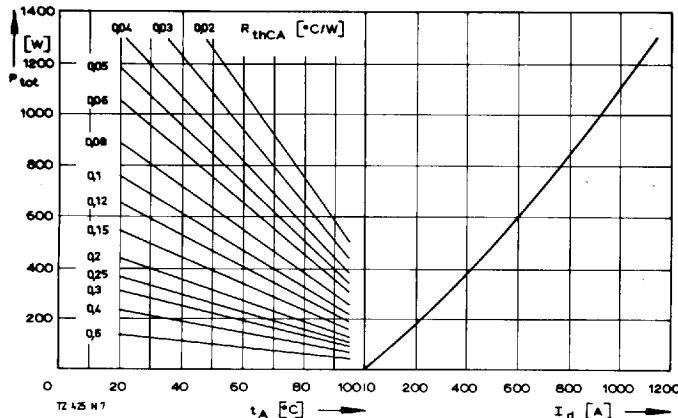


Bild/Fig. 5  
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit  
Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-temperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



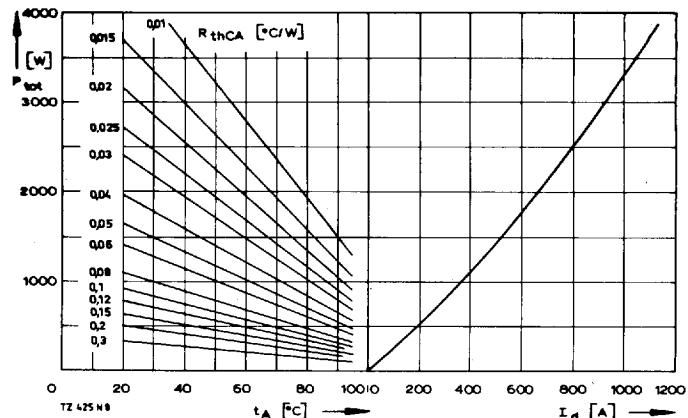
Bild/Fig. 6  
B6 – Sechspuls-Brückenschaltung/Six-pulse bridge circuit  
Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-temperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$

## TZ 425 N



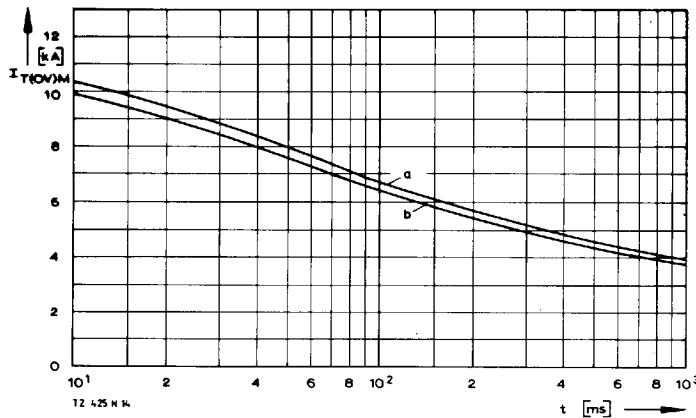
Bild/Fig. 7

W1C – Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit  
Höchstzulässiger Strom  $I_{d,RMS}$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable current  $I_{d,RMS}$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



Bild/Fig. 8

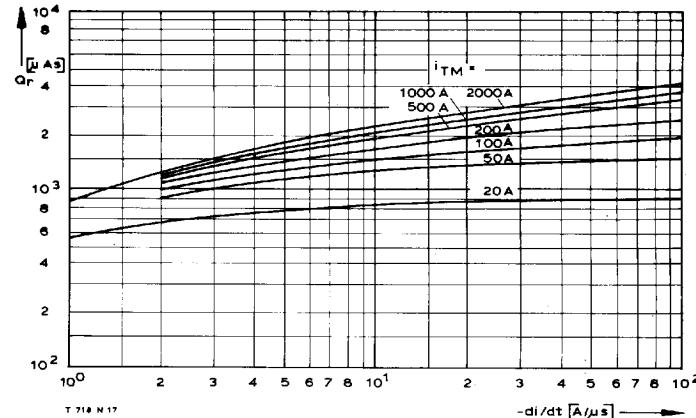
W3C – Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit  
Höchstzulässiger Strom je Phase  $I_{d,RMS}$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-  
temperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable current per phase  $I_{d,RMS}$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



Bild/Fig. 9

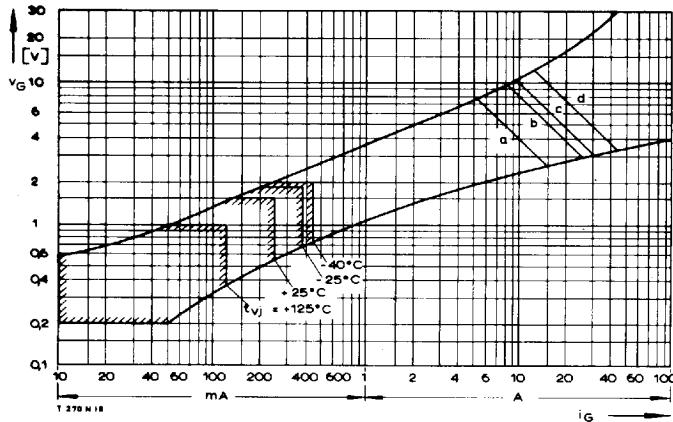
Grenzstrom  $I_{T(OV)M}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A = 45^\circ\text{C}$  (b) und verstärkter  
Luftkühlung,  $t_A = 35^\circ\text{C}$  (a), Kühlkörper KP033S,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Limiting overload on-state current  $I_{T(OV)M}$  at natural ( $t_A = 45^\circ\text{C}$ ) and  
forced ( $t_A = 35^\circ\text{C}$ ) cooling, heatsink type KP033S,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
a – Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions  
b – Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom  $i_{TAVM}$

Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current  
rating  $i_{TAVM}$



Bild/Fig. 10

Sperrverzögerungsladung  $Q_r$  in Abhängigkeit von der abkommunizierenden  
Stromsteilheit  $-di/dt$  bei  $t_{vj} = t_{vj,\max}$ ,  $V_R = 0.5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Der angegebene Verlauf ist gültig für 90% aller Elemente.  
Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current  
 $-di/dt$  at  $t_{vj} = t_{vj,\max}$ ,  $V_R = 0.5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
These curves are valid for 90% of all devices.  
Parameter: Durchlaßstrom  $i_{TM}$ /On-state current  $i_{TM}$



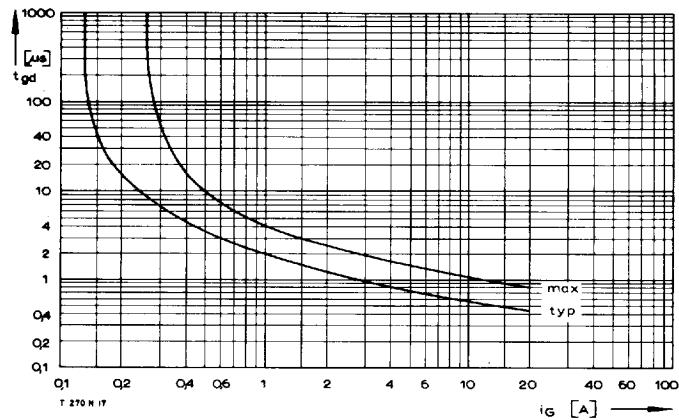
Bild/Fig. 11

Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei  $V_D = 6$  V.  
Gate characteristic and peak gate power dissipation at  $V_D = 6$  V.

Parameter:  $a$   $b$   $c$   $d$

Steuerimpulsdauer/Pulse duration  $t_g$  [ms]  $a$   $b$   $c$   $d$

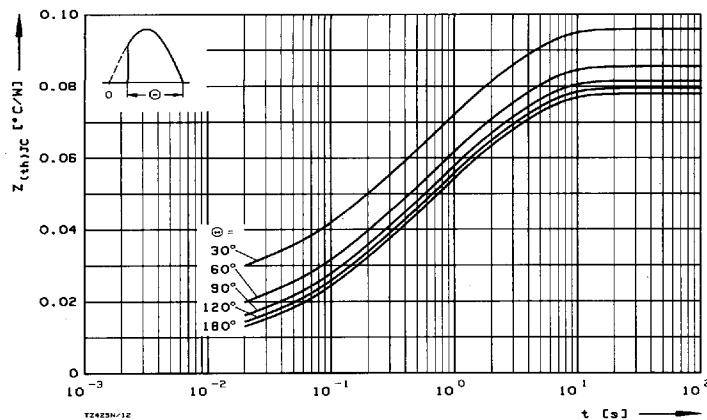
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/  
Maximum allowable peak gate power [W]  $a$   $b$   $c$   $d$



Bild/Fig. 12

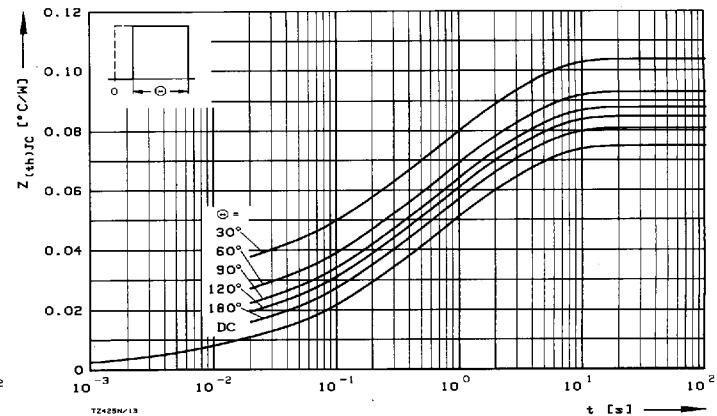
Zündverzug/Gate controlled delay time  $t_{gd}$ ,  
 $t_a = 1 \mu\text{s}$ ,  $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ .

## TZ 425 N



Bild/Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand  $Z_{thJC}$ .  
Transient thermal impedance  $Z_{thJC}$ , junction to case.



Bild/Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{thJC}$ .  
Transient thermal impedance, junction to case, per arm  $Z_{thJC}$ .

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00194	0,00584	0,01465	0,0254	0,0267
$\tau_n$ [s]	0,000732	0,00824	0,108	0,57	3,0

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-t/\tau_n})$$

Transienter Wärmewiderstand  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC.  
Transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC.